



OLS910 光伏发生器 (8192)

● 概述

该光伏发生器为红外发光二极管输入，光伏二极管阵列输出，用于MOSFET的驱动。采用LCC06 陶瓷气密式密封，体积小、耐振动、抗冲击，能在恶劣环境下可靠工作，可供航空、航天及其它电子设备中MOSFET的隔离、驱动，可直接替代进口同型号产品。

● 主要技术指标 (环境温度 25°C)

表 1 最大额定值

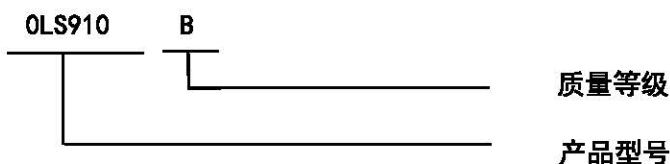
特性参数	符号	最小	最大	单位
输入参数				
平均输入电流	I_F		50	mA
耗散功率	P_D		100	mW
反向电压	V_R		5	V
最大漏电流	I_F		100	μA
输出				
正向电压	V_F		20	V
反向电压	V_R		200	V
耦合				
隔离电压	V_{ISO}		1500	V
工作温度	T_{amb}	-55	+125	°C
存储温度	T_{stg}	-65	+150	°C
焊接温度			+240	°C

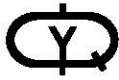
表 2 主要光电特性参数

特性参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
开路电压	V_{oc}	$I_F=10\text{ mA}$	7.5	13.0		V
短路电流	I_{sc}	$I_F=10\text{ mA}$	7	20		μA
正向压降	V_F	$I_F=10\text{ mA}, T_a=25^\circ\text{C}$	2.4	2.8	3.2	V
		$I_F=\pm 10\text{ mA}, T_a=-55^\circ\text{C}$	+2.8		+3.6	V
		$I_F=10\text{ mA}, T_a=125^\circ\text{C}$	2.2		3.0	V
反向击穿电压	B_{VR}	$I_R=10\ \mu A$	5			V
输出漏电流	I	$R_H \leq 50\%$, 1500 V_{DC} , $T_a=25^\circ\text{C}$ Duration=1 s	—		1	μA
上升时间	T_{ON}	$I_F=10\text{ mA}$, $PW=100\ \mu s$, $f=1\text{ KHz}$, $C=15\text{ pf}$, $T_a=25^\circ\text{C}$, $RL=100\text{ M}\Omega$		60		μs
下降时间	T_{OFF}	$T_{ON}=0V\text{ to }90\%$ $T_{OFF}=V_{oc}\text{ to }10\%$			400	μs

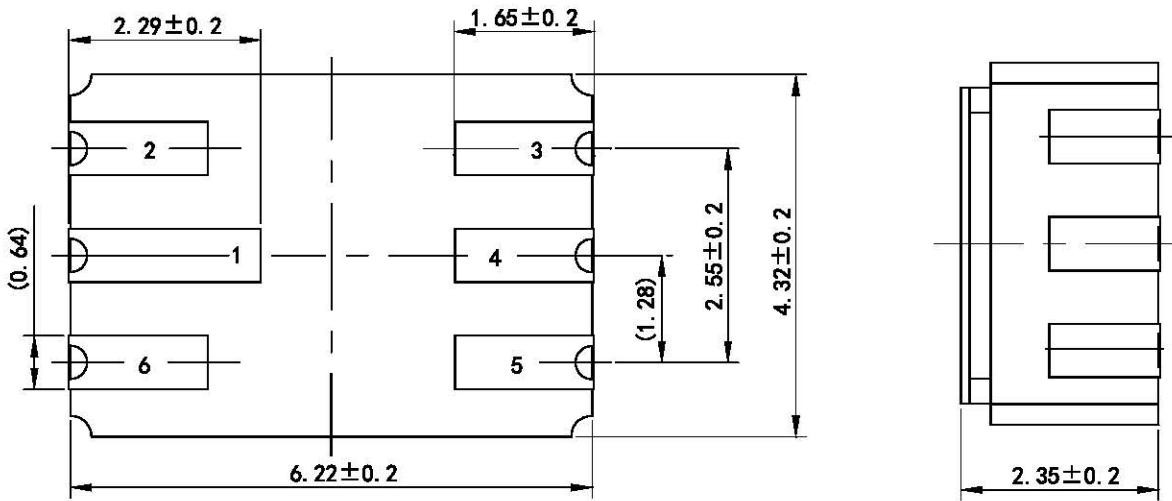
注：1) 产品企业军用标准 Q/RJ 20421-2017，贯彻国家军用标准 GJB 33A-1997；

● 订货标志示例

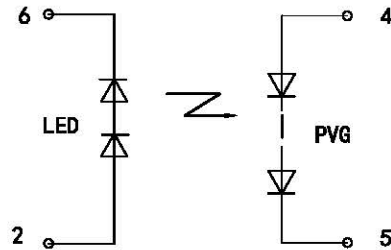




● 外形尺寸图



● 原理框图 (俯视)



● 特性曲线

